性能特点

●高精度 MEMS 微纳米加工

●高性能、全屏蔽、抗干扰微型腔体滤波器

●硅基片、50Ω 共面波导输出

●金丝键合，适用于多芯片集成模块应用

环境参数

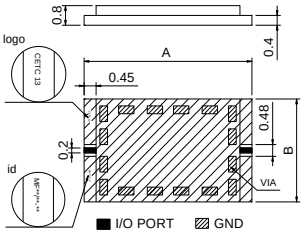
工作温度	-55℃~+85℃
存储温度	-55℃~+125℃
最高输入功率	35dBm

电特性(T_A=+25℃)

项目	最小值	典型值	最大值	单位
中心频率(f_0)	-	2.18	-	GHz
通带频率范围	1.75	-	2.6	GHz
带内波动	-	-	1	dB
中心插损	-	-	2.5	dB
回波损耗	15	-	-	dB
带外衰减	≥30@1.4GHz&3.1GHz			dB
	≥40@1.3GHz&3.2GHz			dB
	≥60@DC~1.0GHz			dB
	≥60@3.5~5.5GHz			dB
时延波动	≤1@1.75~2.6GHz			ns
线性相位	≤±13@1.75~2.6GHz			°

S2P 文件名：SiMF2R18_R85-8D2.s2p

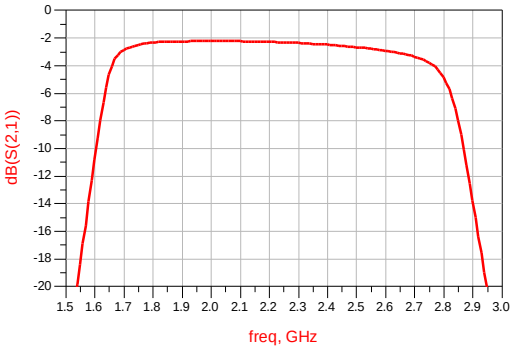
外形尺寸



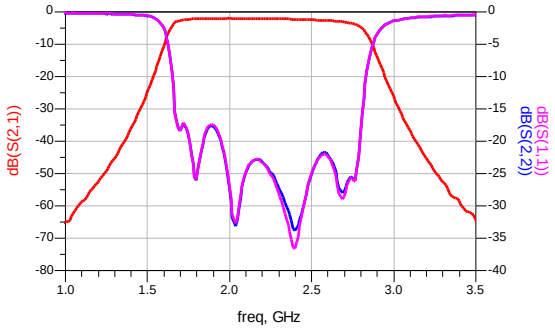
尺寸符号	数值(mm)		
	最小值	公称值	最大值
A	6.9	-	7
B	10.1	-	10.2

典型测试曲线

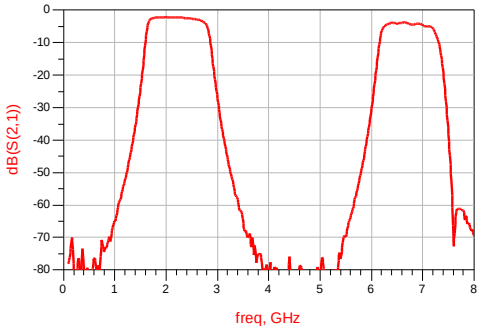
通带损耗 VS 频率(T_A=25℃)



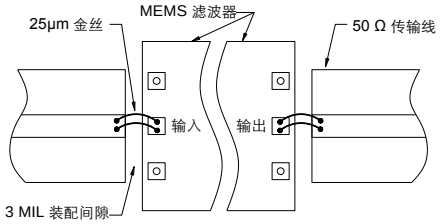
带外抑制 & 回波损耗 VS 频率(T_A=25℃)



远端抑制 VS 频率(T_A=25℃)

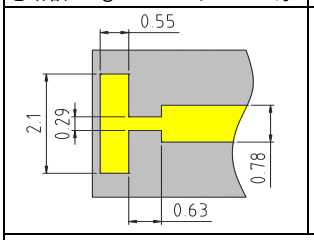
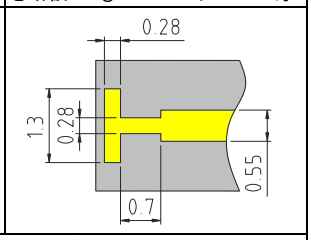


建议装配图



注意事项：

1. 芯片建议分腔使用，两侧距侧壁 0.2mm，表面距上盖 3mm，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数(2.9ppm/℃)相当的载体上，载体厚度≥0.2mm；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带线键合处采用 T 型结构进行匹配，T 型尺寸如下：

电路板 Rogers 5880，10mil 厚	电路板 Rogers 4350，10mil 厚
	

注：T 型图形顶端基板白边 0.1mm；频率 10GHz 以下无需匹配

5. 有问题请与供货商联系。

返回选型目录